

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第1区分

【発行日】平成18年5月11日(2006.5.11)

【公表番号】特表2005-521423(P2005-521423A)

【公表日】平成17年7月21日(2005.7.21)

【年通号数】公開・登録公報2005-028

【出願番号】特願2003-582315(P2003-582315)

【国際特許分類】

C 12 N 7/00 (2006.01)

【F I】

C 12 N 7/00

【手続補正書】

【提出日】平成18年3月15日(2006.3.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

a)宿主細胞の増殖のための生理的に最適な温度より低い温度で、適当な培地において宿主細胞を接種及び培養し、

b)該宿主細胞にウイルスを感染させて、ウイルス感染宿主細胞を得、

c)ウイルスの產生のための生理的に最適な温度またはその付近で、該ウイルス感染宿主細胞を培養し、

d)ウイルスおよび/またはウイルス含有細胞を該培養から回収し、

e)宿主細胞および培養混入物からウイルスを精製して、精製ウイルス産物を得ることを含んでなる、ウイルスの製造方法。

【請求項2】

a)宿主細胞の増殖のための生理的に最適な温度またはその付近で、適当な培地において宿主細胞を接種及び培養し、

b)工程a)の宿主細胞培養の温度を、宿主細胞の増殖のための生理的に最適な温度より低い温度まで変化させ、

c)工程b)の宿主細胞にウイルスを感染させて、ウイルス感染宿主細胞を得、

d)ウイルスの產生のための生理的に最適な温度またはその付近で、該ウイルス感染宿主細胞を培養し、

e)ウイルスおよび/またはウイルス含有細胞を該培養から回収し、

f)宿主細胞および培養混入物からウイルスを精製して、精製ウイルス産物を得ることを含んでなる、ウイルスの製造方法。

【請求項3】

該宿主細胞に該ウイルスを感染させる前の少なくとも約24時間、該培養温度を亞最適レベルに低下させる、請求項2記載の製造方法。

【請求項4】

該宿主細胞に該ウイルスを感染させる前の全細胞継代までにわたり、該培養温度を亞最適レベルに低下させる、請求項2記載の製造方法。

【請求項5】

a)宿主細胞の増殖を促進するための生理的に最適な温度より低い温度で、宿主細胞を培養し、

- b ) 該宿主細胞にアデノウイルスを感染させて、アデノウイルス感染宿主細胞を得、
- c ) アデノウイルスの産生のための生理的に最適な温度またはその付近で、該アデノウイルス感染宿主細胞を培養し、
- d ) ウィルスおよび／またはウィルス含有細胞を該培養から回収し、
- e ) 宿主細胞および培養混入物からウイルスを精製して、精製ウイルス産物を得ることを含んでなる、アデノウイルスの製造方法。

【請求項 6】

- a ) 宿主細胞の増殖のための生理的に最適な温度またはその付近の温度で、適當な培地において宿主細胞を接種及び培養し、
- b ) 工程 a ) の宿主細胞培養の温度を、宿主細胞の増殖のための生理的に最適な温度より低い温度まで変化させ、
- c ) 工程 b ) の宿主細胞にアデノウイルスを感染させて、アデノウイルス感染宿主細胞を得、
- d ) アデノウイルスの産生のための生理的に最適な温度またはその付近で、該アデノウイルス感染宿主細胞を培養し、
- d ) ウィルスおよび／またはウィルス含有細胞を該培養から回収し、
- e ) 宿主細胞および培養混入物からウイルスを精製して、精製ウイルス産物を得ることを含んでなる、アデノウイルスの製造方法。

【請求項 7】

該宿主細胞に該アデノウイルスを感染させる前の全細胞継代までにわたり、工程 b ) の培養温度を生理的に最適な温度より低い温度に低下させる、請求項 6 記載の製造方法。

【請求項 8】

該宿主細胞に該アデノウイルスを感染させる前の少なくとも24 時間、工程 b ) の培養温度を生理的に最適な温度より低い温度に低下させる、請求項 6 記載の製造方法。

【請求項 9】

工程 b ) における細胞増殖のための温度が 31 ~ 34 である、請求項 6 記載の製造方法。

【請求項 10】

工程 b ) における細胞増殖のための温度が 31 ~ 34 である、請求項 7 記載の製造方法。

【請求項 11】

工程 b ) における細胞増殖のための温度が 31 ~ 34 である、請求項 8 記載の製造方法。

【請求項 12】

工程 a ) における細胞増殖のための温度が 35 ~ 38 であり、工程 b ) における細胞増殖のための温度が 31 ~ 34 である、請求項 7 記載の製造方法。

【請求項 13】

工程 a ) における細胞増殖のための温度が 35 ~ 38 であり、工程 b ) における細胞増殖のための温度が 31 ~ 34 である、請求項 8 記載の製造方法。

【請求項 14】

工程 a ) における細胞増殖のための温度が 35 ~ 38 であり、工程 b ) における細胞増殖のための温度が 31 ~ 34 であり、工程 c ) における感染宿主細胞の増殖のための温度が約 36 ~ 38 である、請求項 7 記載の製造方法。

【請求項 15】

工程 a ) における細胞増殖のための温度が 35 ~ 38 であり、工程 b ) における細胞増殖のための温度が 31 ~ 34 であり、工程 c ) における感染宿主細胞の増殖のための温度が約 35 ~ 38 である、請求項 8 記載の製造方法。